форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A3			ИУ4. 11.03.03.23.05.52.12.001 СБ	Сборочный чертеж	1	
A3			ИУ4. 11.03.03.23.05.52.12.001 Э1	Схема электрическая	1	
				структурная		
A3			ИУ4. 11.03.03.23.05.52.12.001 ЭЗ	Схема электрическая	1	
				принципиальная		
<i>A3</i>			ИУ4. 11.03.03.23.05.52.12.001 ПЭЗ	Перечень элементов	1	
A3			ИУ4. 11.03.03.23.05.52.12.001 ПД1	Сравнение моделирования и	1	
				Экспериментальных данных		
				Детали		
A3		1	ИУ4. 11.03.03.23.05.52.12.002	Плата печатная	1	
				Радиатор HS 185-70 (Китай)	2	
				<u>Диоды</u>		
		2		15SQ045 (Dongguan YFW, Kumaū)	2	VD2, VD3
		3		1N4002	1	VD1
				(Diotec Semiconductor, Германия)		
				<u>Конденсаторы</u>		
		4		K10-17Б X5R 1000nΦ 50B ±10%	1	<i>[</i> 4
				(Murata Electronics, Япония)		
		5		K10-17Б X5R 220πΦ 50B ±10%	1	<i>C1</i>
				(Murata Electronics, Япония)		
		6		К73-17 0,68мкФ 250В ±5%	1	<i>[7</i>
				(Кузнецкий завод конденсато- ров, Россия)		
				<u>и</u> 94.11.03.03.23.05.52.04	4.00	1
Изм Ра	/Іш зраб	-	№ докум. Подп. Дата акулевский	Лит.	Лист	Листов
Пр			эменцов С. Г.			3 . Баумана 1 ИУ4
	Утв.					14 –52 Б

форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		7		K50-35 2200mκΦ 35B ±20%	2	<i>[6, [8</i>
				(JB Capacitors, Гонконг)		
		8		К50-35 мини 47мкФ 50B ±5%	2	C2, C5
				(JB Capacitors, Гонконг)		
		9		К50-35 100мкФ 63B ±5%	1	<i>[3</i>
				(JB Capacitors, Гонконг)		
				<u>Разьёмы</u>		
		10		Гнездо стерео 3,5мм ST-025	1	XS1
				(Dragon City Industries, Kumaū)		
		11		Клеммник разъёмный 15EDGRC- 3.81-03P (Degson, Kumaū)	1	XP1
		12		Клеммник разъёмный 15EDGRC- 3.81-02P (Degson, Kumaū)	1	XP2
				Резисторы		
		13		CF-25 0,25Bm 4.7kOm ±5%	2	R14, R15
				(Тайвань)		,
		14		CF-25 0,25Bm 6800m ±5%	2	R3, R5
				(Тайвань)		
		15		CF-25 0,25Вт ЗкОм ±5%	2	R12, R13
				(Тайвань)		
		16		CF-25 0,25Bm 20k0m ±5%	1	R11
				(Тайвань)		
		17		CF-25 0,25Bm 1,2ĸOm ±5%	1	<i>R7</i>
				(Тайвань)		
		18		CF-25 0,25Вт 2кОм ±5%	1	R14
				(Тайвань)		
		19		CF-100 1Bm 100m ±5%	1	R18
				(Тайвань)		
Изм	Лu	CM .	№ докум. Подп. Дата	4. 11.03.03.23.05.52.04	.001	Лист 2

форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		20		CF-100 1Вт 15кОм ±5%	1	R4
				(Тайвань)		
		21		SQP 5Bm 0,10m ±5%	2	R16, R17
				(Тайвань)		
		22		3296W-1-1-2LF 0,25Вт 1кОм ±20% (Bourns, США)	1	RP1
				<u>Транзисторы</u>		
		23		BC546B	3	VT3, VT4, VT6
				(Diotec Semiconductor, Германия)		
		24		BC556B	3	VT1, VT2, VT5
				(Diotec Semiconductor, Германия)		
		25		IRF540NPBF	1	VT7
				(Infineon Technologies, Германия)		
		26		IRF9540NPBF	1	VT8
				(Infineon Technologies, Германия)		
	_	+	 		<i>ባበ1</i>	Лист
Изм	Лu	CM	№ докум. Подп. Дата	T. 11.02.02.22.02.22.04.0		3